

# 電気学会研究会資料目次

## 電子材料 合同研究会 電子デバイス

- 〔委員長〕羽路伸夫（横浜国立大学）  
〔幹事〕岡田至崇（筑波大学），西川宏之（芝浦工業大学）  
〔委員長〕益一哉（東京工業大学）  
〔幹事〕荒川太郎（横浜国立大学），上野和良（芝浦工業大学）  
大見俊一郎（東京工業大学）  
〔幹事補佐〕本間哲哉（芝浦工業大学）

日時 平成18年11月28日（火）9：30～17：45

場所 首都大学東京南大沢キャンパス 理・工教室棟2階204号室  
(〒192-0397 東京都八王子市南大沢1-1 <http://www.metro-u.ac.jp/access.htm> 参照)

### テーマ「半導体パワーデバイス，材料一般」

- EFM-06-25 MOCVD 選択成長による低オーミックコンタクト形成  
EDD-06-100  
戸田典彦，見田充郎，伊藤正紀，  
丸井俊治，星 真一，佐野芳明，関 昇平（沖電気工業）…………… 1
- EFM-06-26 高耐圧 GaN-HEMT における電流コラプスのフィールドプレート構造依存性  
EDD-06-101  
齋藤 渉，蔵口雅彦，高田賢治，津田邦男，  
齋藤泰伸，野田隆夫，大村一郎，山口正一（東芝）…………… 7
- EFM-06-27 高出力 AlGaN/GaN HFET の電源応用  
EDD-06-102  
池田成明，神林 宏，李 江，  
増田 満，野村剛彦，吉田清輝（古河電気工業）…………… 11
- EFM-06-28 セルフアラインプロセスにより作製した GaN 系縦型トランジスタ  
EDD-06-103  
森田竜夫，中澤敏志，上田哲三，田中 毅（松下電器産業）…………… 17

EFM-06-29 EDD-06-104	絶縁ゲート AlGaN/GaN-HFET の縦型動作	兼近将一（豊田中央研究所） 杉本雅裕（トヨタ自動車） 副島成雅，上田博之，石黒 修，樹神雅人， 林 栄子，上杉 勉，加地 徹（豊田中央研究所） ……	21
EFM-06-30 EDD-06-105	シリコンパワー素子の現状	大村一郎（東芝セミコンダクター社） ……	25
EFM-06-31 EDD-06-106	シリコン・パワートランジスタ開発者の新材料パワーデバイスへの期待	高田育紀（三菱電機） ……	31
EFM-06-32 EDD-06-107	Si パワーデバイス Super Junction MOSFET 開発 ー トレンチ埋込エピタキシャル成長技術による Si-Limit 突破ー	山内庄一，柴田 巧，山口 仁（デンソー） 野上彰二，山岡智則（SUMCO） 服部佳晋（豊田中央研究所） ……	37
EFM-06-33 EDD-06-108	SiC 結晶成長と欠陥評価	土田秀一（電力中央研究所） ……	43
EFM-06-34 EDD-06-109	最近の SiC デバイスプロセス技術	福田憲司（産業技術総合研究所） ……	49
EFM-06-35 EDD-06-110	GaN on Si パワーデバイスの開発動向	後藤博一（サンケン電気） ……	53

協 賛 次世代ハイパワー応用ワイドギャップ半導体材料技術調査専門委員会  
パワーデバイス高性能化・高機能化技術調査専門委員会